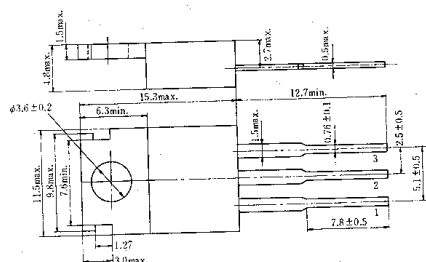


# 2SC1722

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

低周波電力増幅用  
TV 水平、垂直励振用



1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AB)

### ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SC1722	Unit
コレクタ・ベース電圧		$V_{CBO}$	300	V
コレクタ・エミッタ電圧		$V_{CEO}$	300	V
エミッタ・ベース電圧		$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流		$I_C$	0.2	A
許容コレクタ損失		$P_C^*$	12.5	W
許容コレクタ損失		$P_C$	1.8	W
接合部温度		$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		$T_{stg}$	-45~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

\* Value at  $T_C=25^\circ\text{C}$

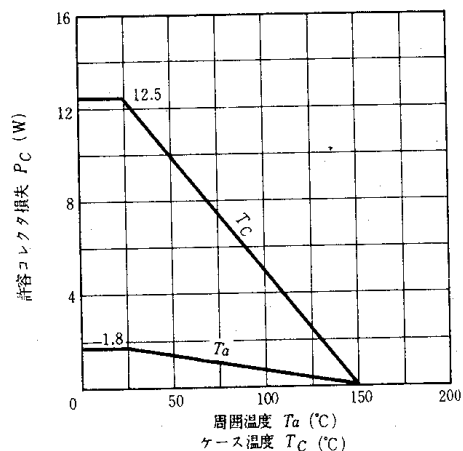
### ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=5\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流		$I_{CBO}$	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
		$I_{CEO}$	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	2	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率		$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	50	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5\text{mA}$	—	1.0	2.0	V
ベース・エミッタ電圧		$V_{BE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	—	0.68	0.9	V
利得帯域幅積		$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=30\text{mA}$	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量		$C_{ob}$	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	4.3	6.0	pF

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP  
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER  
TV HORIZONTAL/VERTICAL DRIV.

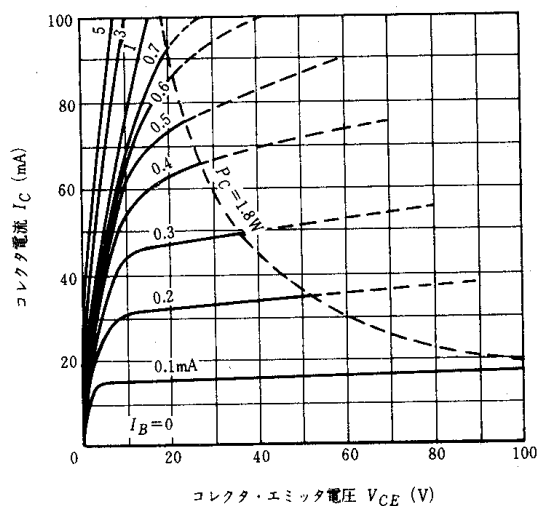
許容コレクタ損失の周囲温度、  
ケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION  
CURVE



エミッタ接地出力静特性

TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



エミッタ接地伝達静特性

TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS

